

Presupuesto	
Número de pieza	FQA55N10
Fabricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	6427 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-3P
Serie	QFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	26 mOhm @ 30.5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	190W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-3P-3, SC-65-3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	98nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	100V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	61A (Tc)

Usted también puede estar interesado

FQA55N10 Palabra clave				
relacionada				
FQA55N10 Fairchild ON Semiconductor	Hoja de datos FQA55N10	Hojas de datos FQA55N10	FQA55N10 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQA55N10
FQA55N10 electrónico	Componentes FQA55N10	Distribuidor FQA55N10	Imagen FQA55N10	Parte FQA55N10
Precio FQA55N10	Fabricante FQA55N10	Imagen FQA55N10	Stock FQA55N10	Inventario FQA55N10
FQA55N10 Nuevo	FQA55N10 Original	FQA55N10 garantizado	FQA55N10 RFQ	FQA55N10 Orden en línea